

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 原 直紀 副委員長 前澤宏一

幹事 葛西誠也・松永高治 幹事補佐 鈴木寿一・新井 学

日時 8月1日(金) 10:30~16:40

会場 機械振興会館地下3階1号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 半導体プロセス・デバイス(表面, 界面, 信頼性), 一般

1. [招待講演] 高感度ミリ波受信用 GaAsSb バックワードダイオード技術
○高橋 剛・佐藤 優・中舎安宏・芝 祥一・原 直紀・岩井大介(富士通研)
2. GaAsSb/InGaAs ヘテロ構造を用いたダブルゲートトンネル FET の理論特性とその実験的検証
○大橋一水・藤松基彦・宮本恭幸(東工大)
3. 転位散乱が InSb HEMT のデバイス特性に与える影響の解析
○初芝正太・長井彰平・藤川紗千恵(東京理科大)・原 紳介・遠藤 聡・渡邊一世・笠松章史(NICT)・藤代博記(東京理科大)

午後(13:30~)

4. [招待講演] 低電圧/高速動作にむけた InGaAs MOSFET ソース構造
○宮本恭幸・金澤 徹・米内義晴・加藤 淳・藤松基彦・柏野壮志・大澤一斗・大橋一水(東工大)
5. III-V DG MOSFET における遅延時間の発生メカニズムの解析
○矢島悠貴・大濱諒子・藤川紗千恵・藤代博記(東京理科大)
6. GaAs JPHEMT P-Type Cap 層によるオフ特性改善
○竹内克彦・谷口 理・柳田将志(ソニー)・佐々木有司・中村光宏(ソニーセミコンダクタ)・和田伸一(ソニー)
7. シートデバイスに向けた塗布型カーボンナノチューブ TFT の作製
○遠藤浩幸・殿内規之・二瓶史行(NEC)・関谷 毅・染谷隆夫(東大)
8. $Al_2O_3/\beta-Ga_2O_3$ ヘテロ接合におけるバンドオフセット
○上村崇史(NICT)・佐々木公平(タムラ製作所)・黄 文海・ダイワシガマニ キルシナムルティ(NICT)・倉又朗人(タムラ製作所)・増井建和(光波)・山越茂伸(タムラ製作所)・東脇正高(NICT)
9. 硬 X 線光電子分光による GaAs 表面の状態解析
○斎藤吉広・鶴見大輔・飯原順次・富永愛子・米村卓巳・山口浩司(住友電工)

【問合先】

上田哲三(パナソニック)

TEL [06] 6906-4940, FAX [06] 6906-2426

E-mail: ueda.tetsuzo@jp.panasonic.com

葛西誠也(北大)

TEL [011] 706-6509, FAX [011] 716-6004

E-mail: kasai@rciqe.hokudai.ac.jp